

【1000 ~ 2000万円】Power Device Design Senior Engineer

外資系デバイスメーカーでの募集です。 電子デバイス研究開発のご経験のある方は歓...

募集職種

人材紹介会社
株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名
外資系デバイスメーカー

求人ID
1586991

業種
通信・キャリア

会社の種類
外資系企業

雇用形態
正社員

勤務地
大阪府

給与
1000万円 ~ 2000万円

勤務時間
09:00 ~ 18:00

休日・休暇
詳細は求人ご紹介時にご案内いたします。

更新日
2026年10月31日 07:00

応募必要条件

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
ビジネス会話レベル

日本語レベル
ネイティブレベル

最終学歴
大学卒： 学士号

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2224778】
・高性能パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）のデザイン開発とテスト検証を担当し、プロセスチームと協力してデバイス加工とプロセスの最適化を行う。
・高性能パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）の個別技術をフォローアップし、既存のデバイスの性能を向上させ、パテントポートフォリオを提案して実現させる。

スキル・資格

必須要件
・半導体/電子/物理などの関連分野を専攻し、5年以上のパワーデバイスのデザイン開発経験（直近の3年間には関連のデザイン開発の従事が必須）、または優秀な博士課程の新卒者。
・パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）の基本構造とデバイスシミュレーションデザイン方法に精通し、TCADソフトやレイアウトソフトを使用しデバイスデザインが得意な方。
・良好なコミュニケーション能力があり、異なる地域や異なる文化背景のチームと良好なコミュニケーションがとれる方。

会社説明

ご紹介時にご案内いたします